

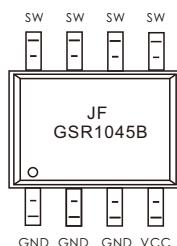
基本功能描述：

GSR1045B是一款内部集成了耐压45V，内阻18mΩ的同步整流器芯片。用于替换Flyback架构电源的输出整流二极管，能够显著减少发热，提升转换效率。GSR1045B通过检测内部集成的MOSFET的源（S）-漏（D）电压来决定其开关状态。可工作于断续、连续或准谐振工作模式。

特点：

- 兼容CCM、DCM（推荐）或QR反激变换器
- 适合于低边整流
- 内部集成18mΩ、45V MOSFET
- 最大150KHz工作频率
- 采用SOP-8封装

封装：SOP-8塑封



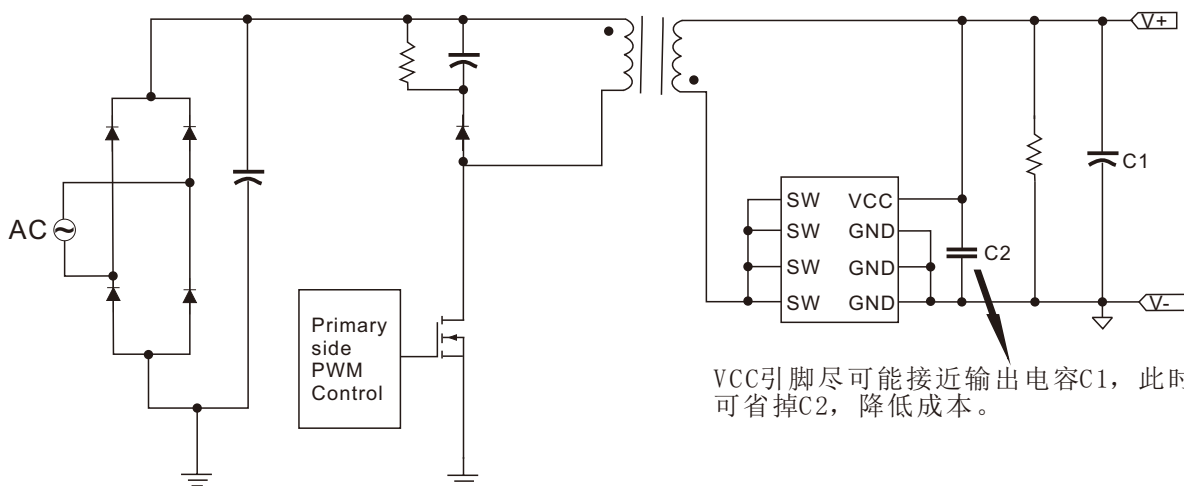
应用：

- 移动设备充电器
- 适配器
- 反激转换器
- 其它类似架构的电源

引脚功能：

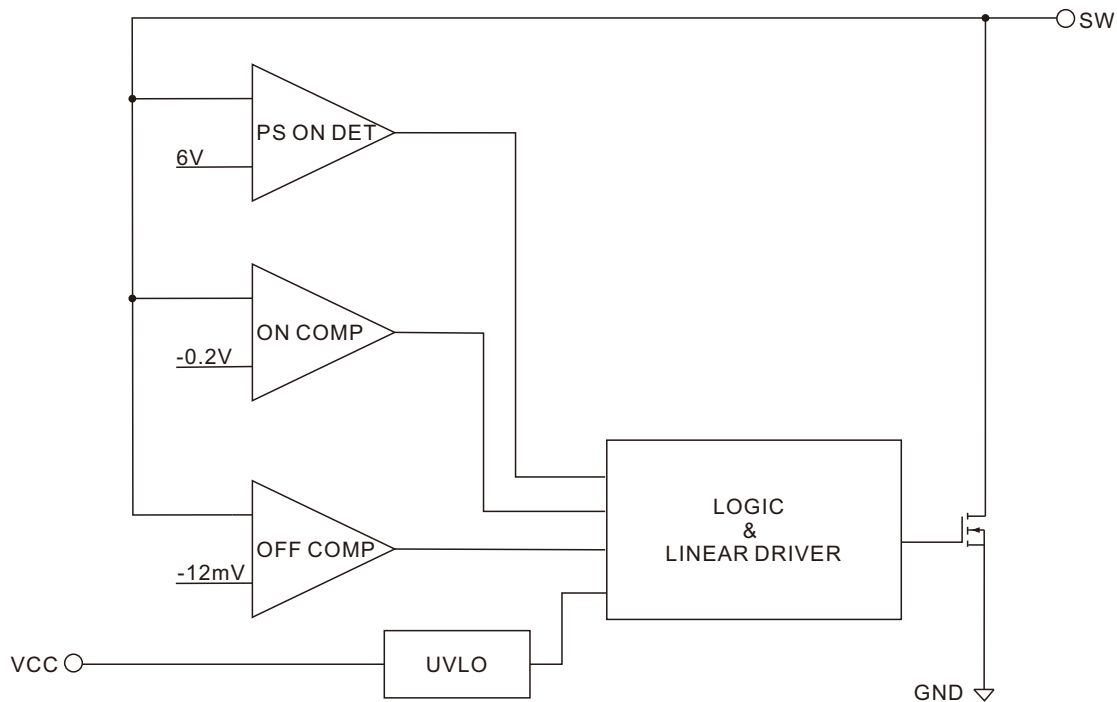
管脚序号	管脚名称	管脚描述
1, 2, 3	GND	芯片地
4	VCC	芯片供电
5, 6, 7, 8	SW	内部MOSFET漏极

典型应用电路：



VCC引脚尽可能接近输出电容C1，此时，可省掉C2，降低成本。

内部框图



推荐工作条件

型号	推荐输出	MOS耐压	MOS内阻	最高工作频率	工作模式
GSR1045B	2.6A	45V	18mΩ	150KHz	DCM

极限电气参数

参数	符号	最小值	最大值	单位
VCC脚耐压	V_{VCC}	-0.3	+7	V
SW脚耐压	V_{SW}	-0.3	+40	V
最大工作频率	F_{MAX}		150	KHz
热阻系数	$R_{\theta ja}$		150	°C/W
工作温度范围	T_{OP}	-25	85	°C
工作结点温度	T_J	-40	150	°C
焊接温度 (10 秒)	T_S		260	°C
存储温度范围	T_{STG}	-55	150	°C
抗静电能力(HBM)	V_{ESD}		4	KV

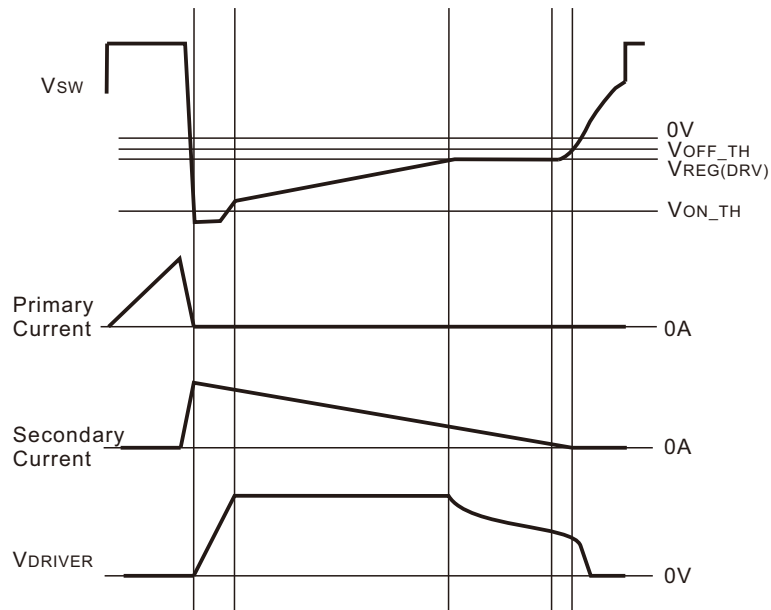
注：超过额定参数所规定的范围将对芯片造成损害，不能保证芯片在额定参数范围以外的工作状态。暴露在额定参数范围以外会影响芯片的可靠性。

电气参数

(除特殊说明外, 以下参数均在 $T_A=25^\circ\text{C}$, $V_{CC}=6.0\text{V}$ 条件下测试)

ITEMS	SYMBOL	CONDITIONS	Min.	Typ.	Max.	UNIT
Input Supply						
VCC UVLO Rising <small>V_{CC}上升时开启电压</small>	V_{UVLO1}	V_{CC} raising	2.95	3.1	3.3	V
VCC UVLO Hysteresis <small>V_{CC}欠压时关闭电压</small>	V_{UVLO2}	V_{CC} falling	2.6	2.8	2.95	V
Quiescent Current <small>静态电流</small>	I_Q	$V_{VCC}=V_{SW}=6\text{V}$	200	400	600	μA
Control Circuitry Section						
Turn-on Threshold(V_D-V_S) <small>同步导通阈值电压</small>	V_{ON_TH}		-300	-200	-100	mV
Turn-on Delay <small>导通延迟时间</small>				80		ns
Turn-off Threshold(V_D-V_S) <small>同步关闭阈值电压</small>	V_{OFF_TH}		-20	-13	-4	mV
Turn-off Delay <small>关闭延迟时间</small>				50		ns
Driver Regulation Voltage <small>同步导通维持电压</small>	$V_{REG(DRV)}$		-40	-30	-22	mV
Minimum ON Time <small>最小导通时间</small>	T_{ON_MIN}		500	640	900	ns
Minimum OFF Time <small>最小关断时间</small>	T_{OFF_MIN}		1.3	1.8	2.5	us
Primary-side On Detection Voltage <small>检测初级测开关闭作有效时的标志电压</small>	$V_{PS_ON_DET}$		5.5	6	6.5	V
Primary-side On Detection Blank Time <small>检测初级测开关闭作有效时的消隐时间</small>	$T_{PS_ON_DET}$		200	300	500	ns
Power MOS						
Drain-to-Source Breakdown <small>MOS耐压</small>	BV_{DSS}		45			V
On-resistor <small>MOS导通电阻</small>	$R_{DS(ON)}$	$V_{GS}=4.5\text{V}, I_D=6\text{A}$		18		m Ω

功能描述 :



GSR1045B

GSR1045B能够支持CCM、DCM和Quasi-Resonant反激转换器，能够提高系统的效率。次级边导通时，电流首先通过功率MOSFET的体二极管，电路检测到功率MOSFET的漏端电压比其源端电压低约0.2V时，立即打开功率MOSFET，降低系统的导通损耗。当Ton超过约640nS时，功率MOSFET驱动的逻辑上拉会闭，而后线性驱动器介入工作。当通过功率MOSFET的电流下降使得漏端电压比源端电压低约30mV时，线性驱动器便会通过降低MOSFET的驱动电压 V_{DRIVER} 使MOSFET的阻抗增大，从而将SW端电压维持在-30mV左右。当电流接近0时，线性驱动器的调节无法将SW电压继续维持在-30mV，SW电压会继续上升。当其电压达到-12mV左右时，芯片会立即通过逻辑将功率MOSFET完全关断。功率MOSFET关闭后，GSR1045B需要检测到SW端电压达到约6V以上，且持续时间大于0.3uS后，才认为是一次有效的原边导通；而后SW下降到-0.2V后立刻打开MOSFET；如未检测到有效的原边导通，但SW仍低于-0.2V，则需要等待大约1.7uS后才打开MOSFET。这样可以在一定程度上避免因谐振干扰造成误动作。

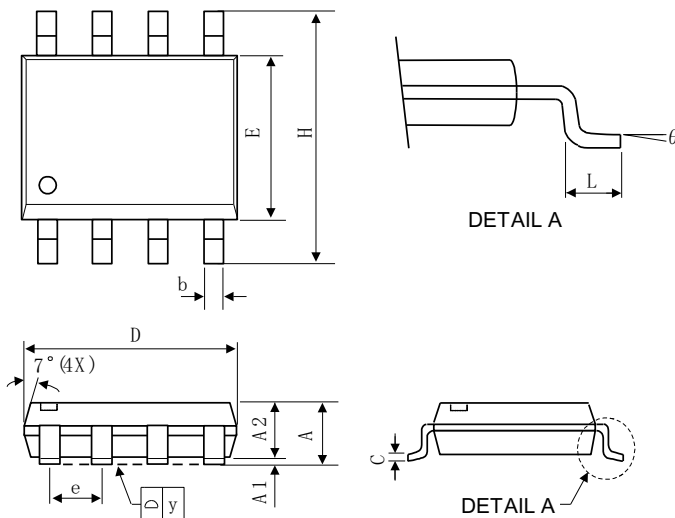
消隐功能

GSR1045B在功率MOSFET开启和关闭后都有消隐功能，确保无论开关都会持续一定时间。其中开启消隐时间为0.64uS，关闭消隐时间设定为1.8uS。

欠压保护功能(UVLO)

当 V_{CC} 降低到 V_{UVLO2} 以下时，电路处于睡眠模式，MOSFET不会被打开。在系统上电后的一段时间，由于 V_{CC} 电压未达到 V_{UVLO1} ，功率MOSFET不会被打开，完全由功率MOSFET的体二极管进行续流，直到 V_{CC} 电压超过 V_{UVLO1} ，芯片开始正常开关。

SOP-8 封装



SYMBOL	MILLIMETER			INCHES		
	MIN	NOM	MAX	MIN	NOM	MAX
A	-	-	1.75	-	-	0.069
A1	0.1	-	0.25	0.04	-	0.1
A2	1.25	-	-	0.049	-	-
C	0.1	0.2	0.25	0.0075	0.008	0.01
D	4.7	4.9	5.1	0.185	0.193	0.2
E	3.7	3.9	4.1	0.146	0.154	0.161
H	5.8	6	6.2	0.228	0.236	0.244
L	0.4	-	1.27	0.015	-	0.05
b	0.31	0.41	0.51	0.012	0.016	0.02
e	1.27 BSC			0.050 BSC		
y	-	-	0.1	-	-	0.004
theta	0°	-	8°	0°	-	8°

UNIT: mm/inch